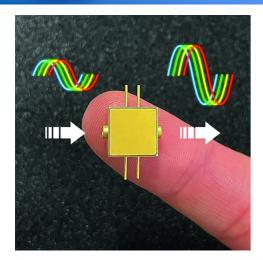
# 超高速化合物半導体による広帯域アナログIC技術

IOWN **Evolution** オンデマンド型 All-Photonics Network

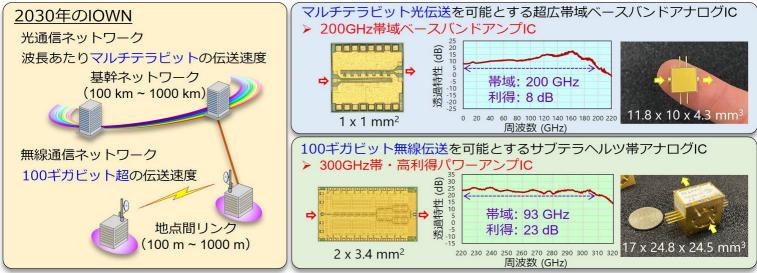


## ▮背景

2030年のIOWNでは、マルチテラビット級の光通信、100ギガビットを超える無線通信が求められます。そのような超大容量通信には、超広帯域、またサブテラヘルツ帯で動作するアナログICが不可欠ですが、トランジスタの動作速度限界や高周波損失により実現が困難でした。

# 成果の概要

独自の化合物半導体トランジスタ技術と回路設計技術の高度化によって、マルチテラビット光伝送を可能とする200GHz帯域ベースバンドアンプICや、100ギガビット無線伝送を実現する300GHz帯パワーアンプICなど、世界最高性能のアナログICの実現に成功しました。



### | 技術のポイント

- NTTで長年培ってきた超高速の化合物半導体トランジスタ技術(InP系へテロ接合バイポーラトランジスタ)を適用
- 高周波での損失を補償し帯域性能を拡張する新しい回路構成法をはじめとし、多数の新しい回路設計アプローチによって世界最高性能のICを実現
- 緻密な電磁界解析技術を駆使することによって、ICを格納して優れたユーザビリティを提供する高性能な小型パッケージ技術の開発に成功

#### ▮この研究がもたらす未来

これらの広帯域アナログIC技術によって、マルチテラビット級の光通信、100ギガビットを超える無線通信を切り拓き、IOWNのさらなる進化を支えます。

#### ■ コラボレーションパートナー

東京丁業大学

#### ▍出展企業

日本電信電話株式会社

#### ■問い合わせ先

rdforum-exhibition@ml.ntt.com